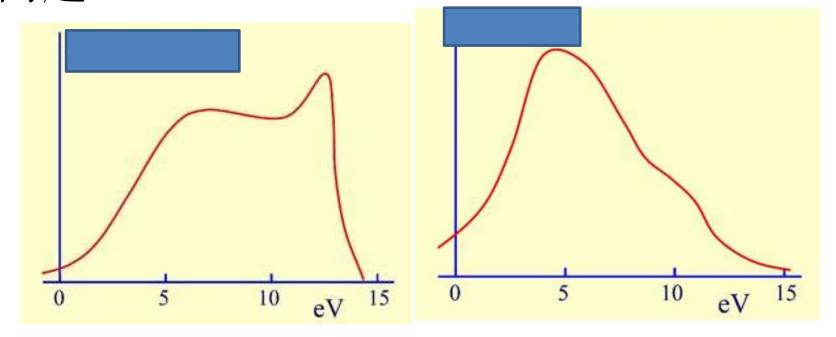
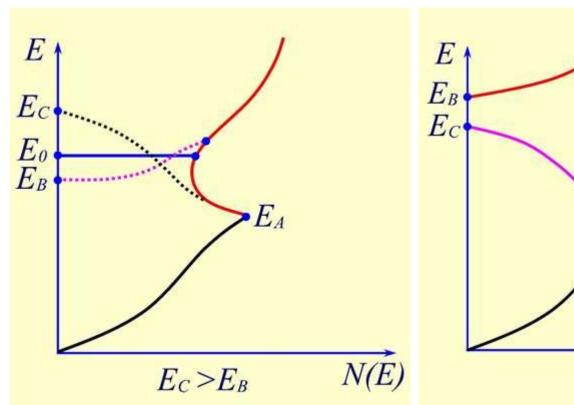
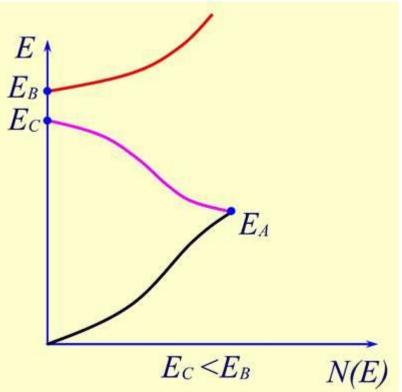
问题1:



X光子谱

判断这两种X光子谱是来自金属还是半导体! 说明判断的理由!





问题2:

• 能够将晶体中的电子看成准经典粒子来处理问题的条件是什么?

波包远远大于原胞,在这一个限度里才能将电子看做是准经典粒子。例如在输运过程中,只有当自由程远远大于原胞的情况下,才可以把电子看做一个准经典粒子。

问题3:

• 晶体中电子在外界作用力下,其运动规律可以写成类似牛顿定律的形式:

$$\frac{d\overrightarrow{v}}{dt} = \frac{1}{m^*}\overrightarrow{F}$$

$$\frac{1}{m^*}$$
名称是什么? $m^* = 1/\frac{1}{m^*}$ 是否正确?

m*为什么有正、有负?

周期性势场力的作用被归并到晶体中电子的质量中 m^* 。 电子通过与原子散射而交换动量,电子从晶格获得的动量大于付出给晶格的动量 $m^*>0$,电子从晶格获得的动量小于付出给晶格的动量 $m^*<0$

理想晶体

一维紧束缚近似下,电子在恒定电场作用下的运动规律 已知条件:

①在无外场条件下电子的能量、速度和有效质量。

电子的能量
$$E^{i}(k) = \varepsilon_{i} - J_{0} - 2J_{1}\cos ka$$

$$v(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{dE(k)}{dk}$$

电子的速度
$$v(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{dE(k)}{dk}$$
 $v(k) = \frac{2J_1 a}{\hbar} \sin ka$

$$m*(k) = \hbar^2 / \frac{d^2E}{dk^2}$$

$$m*(k) = \hbar^2 / 2J_1 a^2 \cos ka$$

分析问题目标: 掌握半导体在热 平衡、非热平衡时,基本半导体 器件结构在热平衡、施加电压时 电子的运动规律、电流-电压特性, 并能够运用所学的半导体的基本 规律对半导体及半导体器件的基 本特性进行识别并正确的表述、 分析。

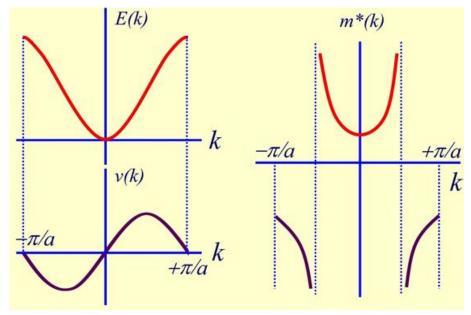
简约布里渊区能带、电子的速度和有效质量

$$E^{i}(k) = \varepsilon_{i} - J_{0} - 2J_{1}\cos ka \qquad v(k) = \frac{2J_{1}a}{\hbar}\sin ka$$

$$m*(k) = \hbar^{2} / 2J_{1}a^{2}\cos ka$$

画图

$$J_1 > 0$$



$$k = 0$$

$$v(k) = 0$$

$$m*(k) = \frac{\hbar^2}{2J_1a^2}$$

能带顶部
$$k = \pm \pi / a$$

$$v(k) = 0$$

$$m*(k) = -\frac{\hbar^2}{2J_1a^2}$$

②在外加低电场作用下电子的运动

电场力 $\vec{F} = -q\vec{E}$ —— 沿k轴的正方向(E沿k的负方向)

$$\frac{\hbar dk}{dt} = F$$
 —— 电子在k空间做匀速运动

$$E^{i}(k) = \varepsilon_{i} - J_{0} - 2J_{1}\cos ka$$

电子的速度
$$v(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{dE(k)}{dk}$$
 $v(k) = \frac{2J_1 a}{\hbar} \sin ka$

$$v(k) = \frac{2J_1 a}{\hbar} \sin(a \frac{1}{\hbar} Ft)$$

电子在k空间做匀速运动

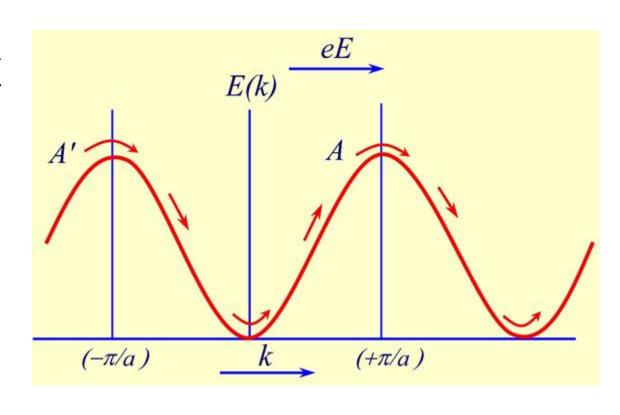
$$\frac{\hbar dk}{dt} = F$$

—— 电子的运动保持在同一个能带内,能量周期性变化

—— k空间布里渊区

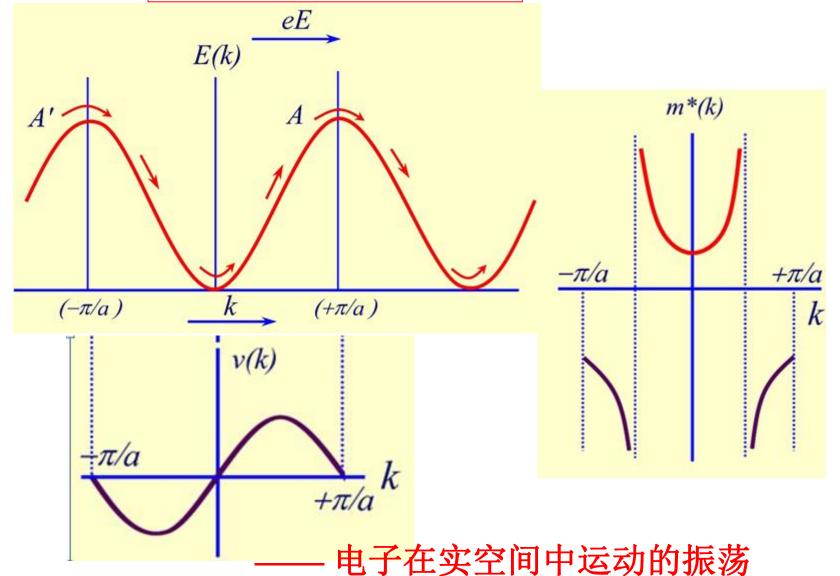
—— 电子从 k=π/a 移动出去

—— 同时从 k= -π/a 移动进来



电子速度振荡
$$v(k) = \frac{2J_1a}{\hbar}\sin a \frac{1}{\hbar}Ft$$
 $m^*(k) = \frac{\hbar^2}{2J_1a^2\cos ka}$

$$m*(k) = \frac{\hbar^2}{2J_1a^2\cos ka}$$



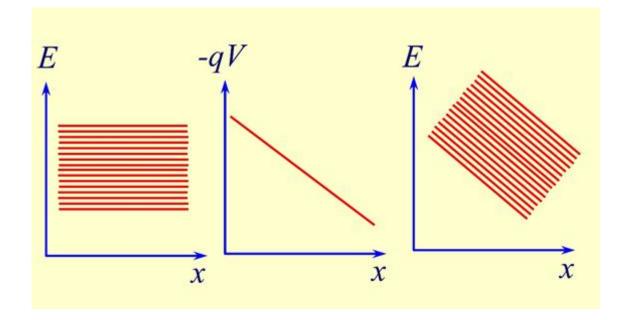
电子运动在实空间中的描述

能带的倾斜 外电场对电子能量本征值附加的能量

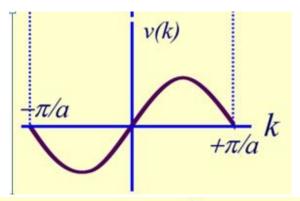
$$E = -\frac{dV}{dx} \qquad V = -Ex \qquad U = -qV = qEx$$

$$U = qEx$$

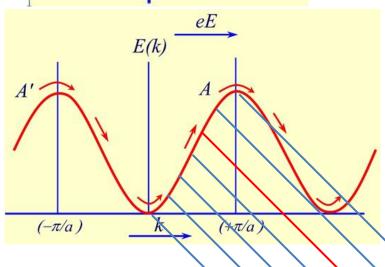
$$E = E_0 + qEx$$



电子运动的振荡



——两个能带的情形中,电子 在实空间的运动振荡



非理想因素?

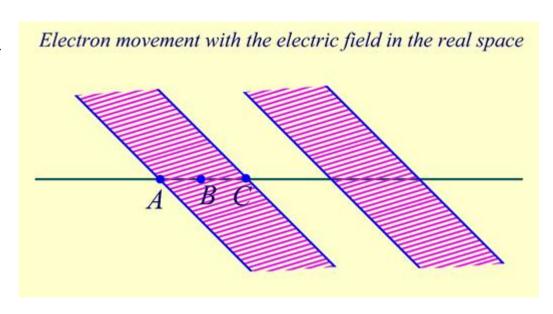
——①电子在运动的过程中,由于<mark>受到声子、杂质和缺陷的散射</mark>(碰撞),相邻两次散射之间的平均时间间隔为电子的平均自由运动时间: τ

—— 如果τ很小,电子来不及完成振荡运动就被散射破坏了

观察电子运动振荡的条件

 $---\omega\tau >> 1$

—— ω振荡圆频率



振荡圆频率
$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$T = \frac{2\pi / a}{v(k)}$$

$$\frac{\hbar dk}{dt} = F$$

$$v(k) = \frac{dk}{dt} = \frac{qE}{\hbar}$$

$$\omega = 2\pi \left(\frac{2\pi / a}{qE / \hbar}\right)^{-1} \qquad \omega \tau >> 1$$

如果 $a \approx 0.3 \text{ nm}, \tau \approx 10^{-13} \text{ s}, \quad \text{则 } E > 2 \times 10^7 \text{ V/m}$

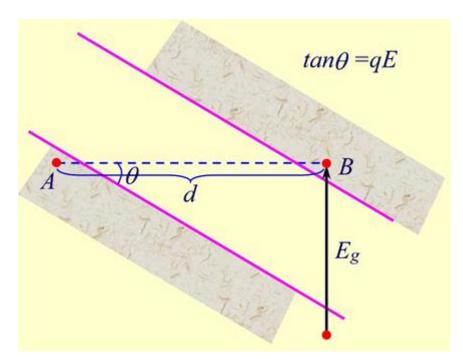
- ——在金属中无法实现
- —— 很难观察到电子的振荡,在一般电场下,在k空间电 子只是发生了一个小位移,无法实现振荡

——②根据量子理论,电子可以发生势垒贯穿效应

穿透位垒的几率

$$\propto E \exp\left[-\frac{\pi^2}{\hbar}\frac{2mE_g}{qE}\left(\frac{E_g}{qE}\right)\right]$$

$$d = \frac{E_g}{qE} - - - - 位垒长度$$



一一 当电场足够强时,若下面的能带被电子填充满,或者接近填充满,上面能带是空带可以接纳电子,此时电子有一定的几率从价带穿透带隙进入导带

—— 隧道效应

§ 5.3 导体、绝缘体和半导体的能带论解释

——问题的提出

—— 所有固体都包含大量的电子,但电子的导电性却相差 非常大

导体的电阻率 $\rho \sim 10^{-6} \Omega \cdot cm$

半导体的电阻率 $\rho \sim 10^{-2} - 10^9 \ \Omega \cdot cm$

绝缘体的电阻率 $\rho \sim 10^{14} - 10^{22} \Omega \cdot cm$

—— 导体、半导体和绝缘体的区别在哪里?

1. 满带中的电子对导电的贡献

电子能量是波矢的偶函数 $E_n(k) = E_n(-k)$

波矢为
$$\vec{k}$$
 的电子的速度 $\vec{v}(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_k E = -\frac{1}{\hbar} \nabla_{-k} E$

波矢为
$$-\vec{k}$$
 的电子的速度 $\vec{v}(-\vec{k}) = \frac{1}{\hbar}\nabla_{-k}E$

$$\vec{v}(\vec{k}) = -\vec{v}(-\vec{k})$$

—— k 状态和 -k 状态中电子的速度大小相等、方向相反

1) 在无外场时,满带

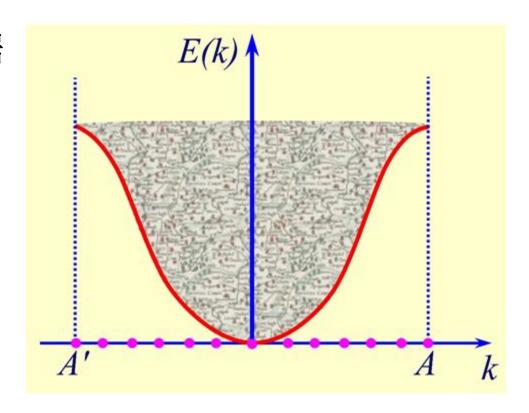
—— \vec{k} 状态和 $-\vec{k}$ 状态中电子的速度大小相等、方向相反

每个电子产生的电流 $-q\bar{v}$

—— 对电流的贡献相互抵消

热平衡状态下,电子占据波矢为 \bar{k} 的状态和占据波矢为 \bar{k} 的状态和占据波矢为 $-\bar{k}$ 的状态的几率相等

—— 晶体中的满带在无 外场时,不产生电流

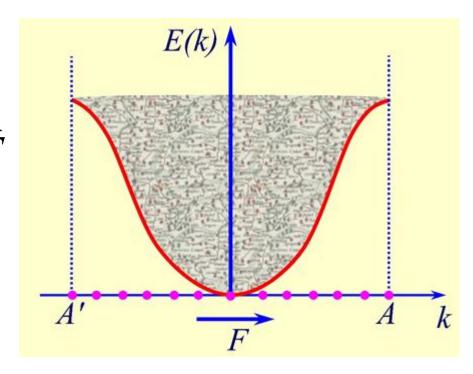


2) 在有外场 \bar{E} 作用时,满带

电子受到的作用力
$$\vec{F} = -q\vec{E}$$

电子动量的变化
$$\frac{d(\hbar k)}{dt} = \vec{F}$$

—— 所有电子状态以相同的速 度沿着电场的反方向运动



$$\frac{d\vec{k}}{dt} = -\frac{1}{\hbar}q\vec{E}$$

—— 满带的情形中,电子的运动不改变布里渊区中电子的 分布,满带中的电子不产生宏观的电流

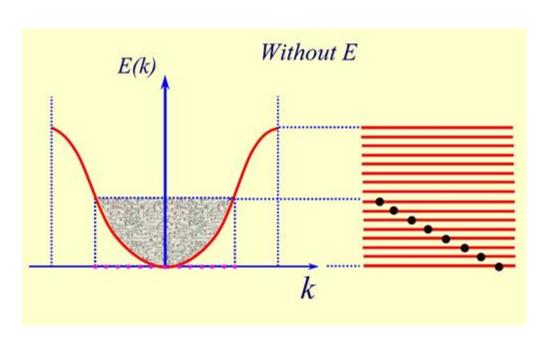
2. 导带中的电子对导电的贡献

1) 无外场存在时

——虽然只有部分状态被电子填充,但波矢为 k 的状态和波矢为 $-\overline{k}$ 的状态中电子的速度大小相等、方向相反,对电流的贡献相互抵消

—— 热平衡状态下,电子 占据两个状态的几率相等

—— 晶体中的导带在无 外场作用时,不产生电流



2) 在有外场作用时

—— 导带中只有部分状态被电子填充,外场的作用会使布 里渊区的状态分布发生变化

—— 所有的电子状态以相同的速度沿着电场的反方向运动, 但由于能带是不满带,逆电场方向上运动的电子较多

$$\frac{d\vec{k}}{dt} = -\frac{1}{\hbar}q\vec{E}$$

—— 在外场作用下, 导带中的电子产生电流

